



ТРАНЗИСТОРЫ ТИПА КТ315А, КТ315Б,
КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж,
КТ315И, КТ315Н, КТ315Р

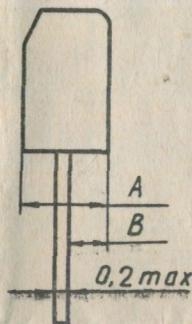
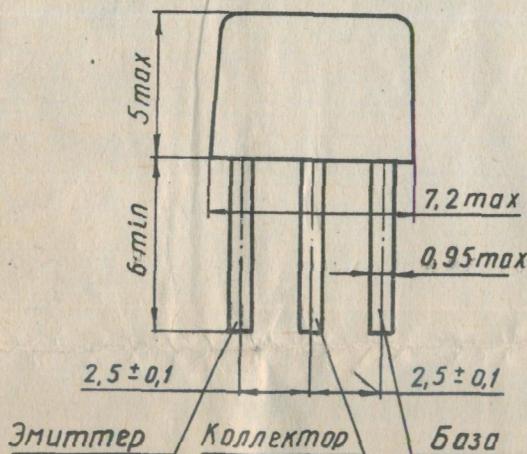


ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы типа КТ315А...Р в пластмассовом корпусе предназначены для применения в усилительных каскадах и других схемах радиоэлектронной аппаратуры, изготавливаемые для нужд народного хозяйства.

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения: 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1;
Б.1.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ



$$A = 3 \text{ мм max}$$

$$B = \frac{A}{2} \pm 0,4 \text{ мм}$$

где A действительный размер

Наличие точки в составе маркировки является отличительным знаком транзисторов, предназначенных для цветного телевидения; допускается применение в другой аппаратуре.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$)

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Тип транзистора	Н о р м а		Примечание
		не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, (при сопротивлении в цепи эмиттер-база $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$)				
$U_K = 25\text{В}$	КТ315А		0,6	
$U_K = 20\text{В}$	КТ315Б, Н		0,6	
$U_K = 40\text{В}$	КТ315В		0,6	
$U_K = 35\text{В}$	КТ315Г, Р		0,6	
$U_K = 40\text{В}$	КТ315Д		1,0	
$U_K = 35\text{В}$	КТ315Е		1,0	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, $U_K = 20\text{В}$ $U_K = 60\text{В}$	КТ315Ж КТ315И		0,01 0,1	
Обратный ток коллектора, мкА, ($U_K = 10\text{В}$)	КТ315А... Г, Н, Р КТ315Д... И		0,5 0,6	
Обратный ток эмиттера, мкА, ($U_Э = 5\text{В}$)	КТ315А... Ж, Н, Р, КТ315И		30 50	
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора ($U_K = 10\text{В}$, $I_Э = 1\text{мА}$)	КТ315А, В КТ315Б, Г, Е, Н КТ315Д КТ315Ж КТ315И КТ315Р	30 50 20 30 30 150	120 350 90 250 — 350	
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте, ($U_K = 10\text{В}$, $I_Э = 5\text{мА}$, $f = 20\text{МГц}$)	КТ315А... Р	12,5		1
Постоянная времени, цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора, пс, ($U_K = 10\text{В}$, $I_Э = 5\text{мА}$, $f = 5\text{МГц}$)	КТ315А КТ315Б... Г, Н, Р КТ315Д, Е КТ315Ж КТ315И		300 500 1000 800 950	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, ($I_K = 20\text{мА}$, $I_B = 2\text{мА}$) ($I_K = 70\text{мА}$, $I_B = 3,5\text{мА}$)	КТ315А... Г, Р КТ315Д, Е КТ315Ж КТ315И КТ315Н		0,4 0,6 0,5 0,9 0,4	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для всего диапазона температур.

2. В диапазоне температур 25°C . . . 100°C $R_{кмах}$ рассчитывается по формуле:

$$R_{кмах} = \frac{t_{п\ max} - t_{окр.}}{0,67} \text{ мВт.},$$

где 0,67 — тепловое сопротивление переход-окружающая среда, °C/мВт.

3. Допустимая эксплуатация приборов типа КТ315А, Б, В, Г, Д, Е, Н, Р, в предельном режиме $R_k = 250 \text{ мВт}$ при $U_k = 12,5 \text{ В}$; $I_k = 20 \text{ мА}$ в течение не более 500 часов.

Содержание драгоценных металлов в 1000 штук транзисторов.

Золото мГ

Цветных металлов не содержится

Сведения о приемке

Транзисторы типов КТ315 соответствуют техническим условиям

ЖКЗ.365.200ТУ

Место для штампа ОТК



Место для штампа

«Перепроверка произведена»

_____ дата

Место для штампа ОТК